

1 Термодинамика плазмы

1.1 Понятие плазмы, квазинейтральность, микрополя, дебаевский радиус, идеальная и неидеальная плазма.

Плазма [1]. Ссылка на уравнение (1), Рис. 1.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (1)$$

1.2 Условие термодинамического равновесия, термическая ионизация, формула Саха, корональное равновесие, снижение потенциала ионизации.

Картинка

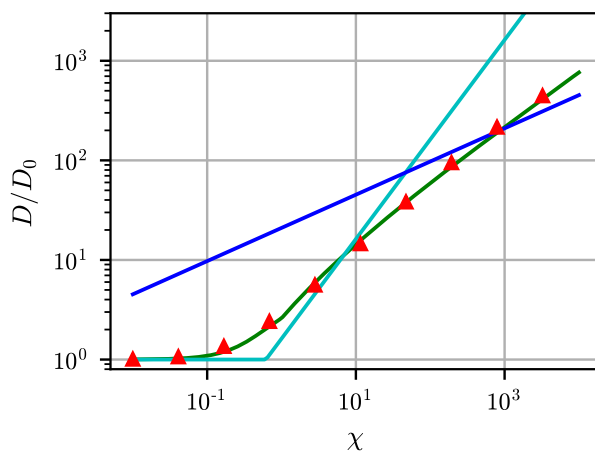


Рис. 1: Подпись.

1.3 Вырождение плазмы, статистика Больцмана и Ферми—Дирака, модель Томаса—Ферми.

2 Элементарные процессы

2.1 Столкновения заряженных частиц, дальное действие.

[Ю.П. Райзер, Физика Газового разряда, 3-е изд, стр. 29]

Из всех сил взаимодействия между атомными частицами медленнее всего спадают с расстоянием (как $1/r^2$) кулоновские силы. Они обладают наибольшим дальним действием. За время пролёта t мимо иона, электрон отклоняется на угол θ . Его можно оценить как отношение полученной поперечной скорости к изначальной скорости:

Основную роль в рассеянии играют столкновения с большим прицельным параметром ρ (рассеяние на малые углы), реализуются при $\rho > r_0$ - Кулоновского радиуса (радиус при котором кин. энергия электрона равна потенциальной $mv^2/2 = e^2/r_0, r_0 = e^2/mv^2$). С другой стороны, потенциал иона спадает $\sim \exp(-r/d)/r$. То есть основной вклад вносят столкновения с прицельным параметром от r_0 до d (радиус дебая). Поэтому полное сечение для кулоновских рассеяний $\sigma = \pi * r_0^2 \int_{r_0}^d r_0 d\rho / \rho = \pi * r_0^2 * \ln d / r_0$

$\ln d / r_0$ - Кулоновский логарифм.

Столкновения атомных частиц могут иметь упругий и неупругий характер. При упругом соударении меняются направления движения партнеров, происходит обмен импульсом и кинетической энергией, но внутренние энергии и состояния частиц остаются неизменными.

2.2 Частоты столкновений

[Ю.П. Райзер, Физика Газового разряда, 3-е изд, стр.20]

Число соударений определенного рода, которые данная частица (назовем: ее 1) в среднем совершает в 1 с, двигаясь в газе из частиц мишеней 2, называют частотой столкновений.

$$\nu_1 = N_2 * v' * \sigma(v'), \text{ где } v' \text{ скорость сближения}$$

Для газовой кинетики это тоже работает и если распределение частиц массы М по абсолютным скоростям описывается максвелловской функцией, то вместо скорости надо ставить среднее её значение $\bar{v}' = \sqrt{2}\bar{v}$; $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi M}}$, где за массу надо брать приведённое её значение по 2-м частицам ($M = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$), а за сечение рассеяния πd_{mol}^2

2.3 Столкновения электронов с атомами (упругие и неупругие)

2.3.1 Упругие

[Астапенко В.А., Лисица В.С., столкновительные процессы в стр.30]

Вычисление сечения процесса является сложным кванто-механическим расчетом и зависит от скорости налетающего электрона. Транспортное сечение выражается сложным образом

$$\sigma_{tr} = 4\pi(L^2 + \frac{4}{5}\frac{\pi\alpha L}{a_{bor}}\frac{mV}{\hbar} + \frac{\pi^2}{6}\frac{\alpha^2}{a_{bor}^2}(\frac{mV}{\hbar})^2)$$

Здесь L - длина рассеяния электрона на атоме. Первый член - короткодействующие силы. Последний - дальнодействующий потенциал деполяризационный. Промежуточный - интерференционный от предыдущих двух (проявляются волновые свойства электрона), он может быть отрицательным (при отрицательном L). Как именно происходит интерференция - см [И. мак-Даниэль, процессы столкновений в ионизированных газах, гл. 4, §4, стр 161] и [гл. 3, §15, пункт Д, "рассеяние S волны на сферической потенциальной яме"]

2.3.2 Неупругие

Ионизация

[Астапенко В.А., Лисица В.С., столкновительные процессы в стр.37]

Так как после ионизации мы имеем ситуацию, что электрон улетает от иона, то это мы можем рассматривать как упругое рассеяние электрона на ионе, однако в сечение войдут не все электроны, а лишь с энергией выше, чем E_{ion}

$$\frac{d\sigma^{(R)}}{d\Omega} = (\frac{Ze^2}{2mV^2 \sin^2(\frac{\theta}{2})})^2$$

При рассеянии иону передается импульс $\Delta p = 2mV \sin(\theta/2)$ и соответственно энергия $\Delta E = 4E \sin^2(\theta/2)$, поэтому можно перейти к интегрированию по энергиям. $\delta\sigma = \frac{\pi e^2 d\Delta E}{E(\Delta E)^2}$; $\sigma_{ion} = \int_{E_{ion}}^E d\sigma = \frac{\pi e^4}{E} (\frac{1}{E_{ion}} - \frac{1}{E}) = \frac{\pi e^4}{E_{ion}^2} \frac{x-1}{x}$, где $x = E - E_{ion}$, то есть ионизация имеет пороговый характер

Возбуждение электронным ударом [Астапенко В.А., Лисица В.С., столкновительные процессы в стр.50]

Уравнение рассматриваемого процесса имеет вид $e + A \rightarrow A^* + e$. Согласно этому принципу атом при взаимодействии с электромагнитным полем ведёт себя как набор осцилляторов, которые ставятся в соответствие паре энергетических уровней E_i , E_j атомного спектра. Собственные частоты этих осцилляторов равны собственной частоте перехода $i \rightarrow j$, $\omega_{i,j} = \frac{(E_j - E_i)}{\hbar}$, а эффективность их взаимодействия с электромагнитным полем определяется силой осциллятора: $f_{i,j} = \frac{2m\omega_{i,j}|d_{ij}|^2}{3\hbar e^2 g_i}$, где g_i - статистический вес начального состояния.

При кванто-механическом описании дипольный момент осциллятора перехода d_{ij} представляет собой матричный элемент оператора электрического дипольного момента между состояниями $|i\rangle$, $|j\rangle$. В случае возбуждения атома $i, j > 0$ и $f_{i,j} > 0$, для электронного перехода с уменьшением энергии $i, j < 0$ и $f_{i,j} < 0$. Также может быть $f_{i,j} = 0$, тогда такие переходы называются дипольно-(или оптически) запрещенными. Если $f_{i,j} \neq 0$ оптически-разрешенный переход. Предполагая поле налетающего электрона в области локализации атома однородным, можно записать следующее уравнение для радиус-вектора осциллятора r_{ij} : $r_{ij}'' + \gamma_{ij}r_{ij}' + \omega_{ij}^2 r_{ij} = f_{i,j} \frac{e}{m} E(t, \rho)$, где γ_{ij} -константа затухания, ρ -прицельный параметр. Записывается скорость затухания в таком осцилляторе и ищется работа, которую совершает поле над осциллятором за всё время столкновения. Вероятность возбудить атом будет $W_{ij}(\rho) = \frac{A_{ij}(\rho)}{\hbar_{ij}}$, полное сечение будет $\sigma_{ij} = 2\pi \int_a^{\inf} W_{ij}(\rho) \rho d\rho$. Тут, как и в кулоновском рассеянии основную роль играют рассеяние на малые углы, то есть с большим прицельным параметром. $\sigma_{ij} = \pi f_{ij} \frac{e^2}{m\Delta E_{ij}} \int_a^{\inf} |E(\omega_{ij}, \rho)|^2 \rho d\rho$ Далее - трудные выкладки с методом

функции подобия. Самое главное, характер функции сигмы от энергии. Она выглядит схожим образом с зависимостью сечения ионизации. Также имеет пороговый характер, на бесконечности спадает как $\ln(E)/E$. Имеет максимум в при $E = 3,45 * E_{ij}$. Для запрещенных переходов данный расчёт в дипольном приближении невозможен, ибо носит не дипольный характер. Дипольно-запрещённые переходы бывают двух типов: без изменения спина атома (дипольный момент перехода отсутствует из-за невыполнения правил отбора по орбитальному квантовому числу L , переход осуществляется за счёт прямого кулоновского взаимодействия) и переходы с изменением атомного спина (В этом случае возбуждение атома происходит за счет обменного взаимодействия между налетающим и атомным электроном).

Плазма

Список литературы

- [1] Котельников И. А. *Лекции по физике плазмы.*